

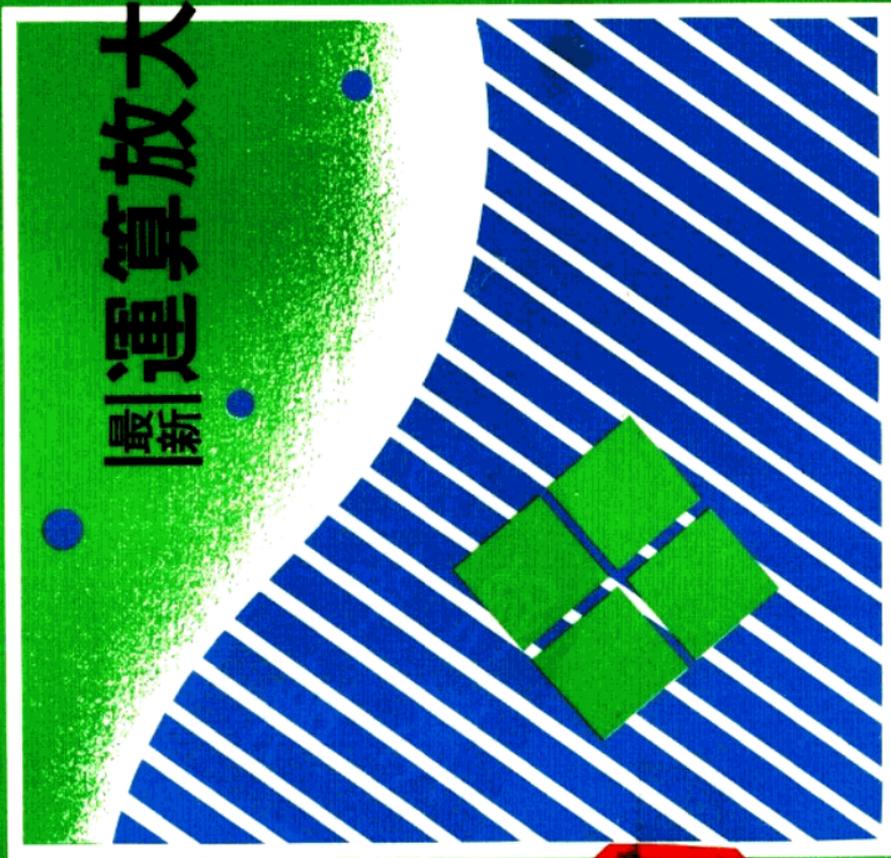
THE OP AMP MANUAL (2 HYBRID OP AMP)

最新大放大器規格表

表(II)

'85

全華科技圖書公司印行



THE OP AMP MANUAL (2HYBRID OP AMP)

266

最新運算放大器規格表(II)

85



全華科技圖書公司印行



全華圖書 版權所有 翻印必究
局版台業字第0223號 法律顧問：陳培臺律師

最新運算放大器規格表(2)

全華編輯部 編譯

出版者 全華科技圖書股份有限公司
北市龍江路76巷20-2號
電話：581-1800·564-1819
581-1362·581-1347
郵政帳號：100336

發行人 陳本源
印刷者 欣瑞彩色印刷廠
定價 90元
初版 中華民國74年11月

THE OP AMP MANUAL (2HYBRID OP AMP)

最新 運算放大器規格表(II)

85

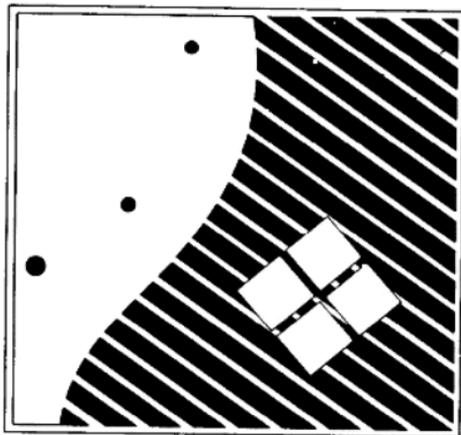


全華科技圖書公司印行



最新 OPアンプ 規格表

ハイブリッド編



☆規格表ご利用の際のお願い

本規格表の仕様はメーカー発表の資料に基づき作成しておりますが、メーカーによって予告なく規格・外形等を変更する場合がありますので、量産品等、大量に素子を使用して製品を生産する際には、事前に該当メーカーにお問合わせの上、仕様をご確認ください。

運算放大器規格表的彙集

本規格表收集了全世界各廠商所製造之運算放大器。隨著電子工業的急速發展，運算放大器的特性也有更高度的要求，且需要量增加，使得較舊及產品種類年年增加。

編輯本書時，爲了儘可能達到實用目的，把外部的連接電路（如偏移—offset—調整及額率補償電路等）與漂移特性儘可能都列入，因此，使得記載量增加，而分成兩冊。

運算放大器可以照產品種類加以分類，但各廠商大多同時製造單石型(monolithic)及混合型(hybrid)而且，由於實用上以其性能、外觀、價格及廠商等爲主，故在本規格表中，姑且不論廠商別，而按照廠商的主要產品是單石型或混合型分成兩冊。

爲便於查閱，規格表儘可能加以統一，但由各廠商所發表之資料手冊上的記述方式則不一定相同，本表係用彙集方式編成的，因此，部份項目不在收集之內，又由於篇幅有限，故未能將所有特性都列出來，請多包涵。

另外，有關電路圖及外觀圖，因混合型

(尤其是離散型)內部的等效電路大多未發表，因此只記有外觀圖及外部連接圖。至於單石型的運算放大器之標準型(709或741型)，各廠商均有出售，故也可能有重複或

不足之產品；其他，應用不廣的產品也可能會有同樣的情形。

若想知道產品的詳細特性，請直接向各廠商索取個別別的資料手冊。

運算放大器的分類

運算(OP)放大器已有相當多種發表出來，若照構造分類，則有半導體IC和個別零件組成之高密度實裝型。而且，半導體IC又分爲單石型、多晶片型(multi-chip)及混合型等；高密度實裝型也有IC及個別零件組合的混合型。

高密度實裝型的封裝(package)一般稱爲模組(module)型，尺寸稍大。半導體IC，無論是單石型、多晶片型或混合型，都收容在DIL封裝或金屬罐(metal can)等小型的封裝內。

至於本規格表，爲方便起見，分類如次：

BP MON：具有雙極性(bipolar)電晶體輸入電路IC，爲單石晶片。

FET MON：具有J-FET輸入電路之單石晶片，J-FET及雙極性運算放大器集積在同一晶片上。

HYB薄：單石IC和薄矽片所組合而成的，形狀上，DIL封裝，TO-3、TO-99、TO-100及平面封裝等被小型化。FET輸入電路的IC，一般由兩個單石晶片(FET晶片+BP MON晶片)及薄矽電路(阻抗)所形成，屬於HYB薄。

HYB厚：HYB厚的範圍，用單石IC及厚矽電路(阻抗等)混合組成，有高密度實裝型(個別零件組裝型及離散型)。

：一般的OP放大器功率消耗在50mW以上，相對於此，低功耗消耗型OP放大器者在5mW以下($V_{cc} = \pm 15V$)。通常，此型的OP放大器，可在低電源電壓動作，若 V_{cc} 為 $\pm 3V$ 則功率消耗為幾百 μW 。電源為電池或大量使用OP放大器的場合較有利。

電池動作：電池動作的OP放大器，一般在電源電壓低的時候，也可動作(約 $\pm 3V$)，此時，各種特性也不會太差。

低邊：載波型型的OP放大器中，若載波頻率低，則約有100V/Sec的轉動率。

高增益：通用的OP放大器之 A_o 值約為 3×10^5 (A_o 較大者)；載波型型的 A_o 約在140dB左右，至於雙極型的 A_o 也在 10^7 以上，均為高增益。

機功率

而CMR在90dB以上。

低漂移及超低：低漂移之OP放大器中，漂移電壓的溫度變化小，可由移電壓(Ultra low drift)適用的OP放大器裡面選出。內含特別溫度補品片者及載波型者，其漂移特性低， $\Delta V_{io}/\Delta T$ 為 $0.1 \sim 0.2 \mu V/^\circ C$ 。

低偏壓：FET輸入者和變容耦合，偏壓電流很小。變容型約為 $0.01pA$ 而FET型約為 $0.1pA$ 。

高輸出：一般的OP放大器的電源電壓為 $\pm 15V$ ，相對於此，高輸出型OP放大器有 $\pm 100V$ 以上的電源電壓，輸出電壓也有 $100V$ 以上。

高電流：通用OP放大器的輸出電流為 $10 \sim 20mA$ ，而高電流OP放大器者在 $100mA$ 到 $1A$ 左右。

流約為 $0.1pA$ 。

載波器(chopper)：用載波器放大的OP放大器，漂移特性非常低，而且，長時間的變化很小，增益也很大，約可達140dB。載波型幾乎全部為反相輸入，但其中也有差動輸入者。

變容器(varactor)：用變容二極體調變電路的OP放大器，其特徵為非常低的偏壓電流及低的雜訊電流。輸入阻抗則高達 $10^{11}\Omega$ 。

儀錶使用(instrumentation)：測量用差動輸入型的OP放大器，尤其是用於差動輸入電路。增益也可由外加阻抗來調整。

② 按特性分類

高速度、高邊：A/D及D/A轉換器和要求寬頻帶及寬頻高頻帶放大之場合，所用的帶高轉動率、高造型之OP放大器，通用快速穩定

的轉動率為 $5V/\mu S$ 以下，而高造型的轉動率則從數 $10V/\mu S$ 到 $100V/\mu S$ 以上。

高CMR：高CMR OP放大器中，差動電路增益誤差很小，同相輸入阻抗也相當高($10^{10}\Omega$ 左右)，增益在100dB以上。

低偏壓電流

高輸出

高耐壓

高電流

參數的定義

，若不在額定值的範圍內使用，則放大器會遭受永久破壞，或引起特性值的變化而不合規格值等。實際上，超過最大額定值使用，

① 最大額定(絕對最大額定)

最大額定或絕對最大額定是一種額定值

並非所有的放大器一定會選擇，按照其程度，仍有可供實用者（特別挑選的場合等）。但是，在這種狀況下，若放大器壞掉，則廠商不負任何責任，而是使用者的責任。

另外，即使在最大額定內使用，由於電氣特性通常是在某一條件（例如：周圍溫度 25°C 、電源電壓 $\pm 15\text{V}$ ）下測出的，因此也未必能滿足此規格。

最大電源電壓 (V_{cc})

電源電壓的最大額定，為OP P放大器壞掉之前，所能加的最大電源電壓，其正負值均有規定。

關於電源電壓範圍的規定，記有電壓的最小值，表示在該電壓之下，無法正常動作。電源電壓範圍 (V_{cc})

使IC動作的電源電壓範圍。

最大差動輸入電壓 (V_{id})

在不會發生損壞的狀況下，所能加於OP P放大器之差動輸入端間的最大電壓。

最大(同相)輸入電壓 (V_{I})

在不會發生故障的狀況下，所能加於差動放大器的輸入端與接地端間的最大電壓。最大容許損失 (P_D)

放大器等發生熱溫度越壞前，所能使用之值，為電源電壓和電路電流之乘積，若用兩個端子以上的電源時，則為各個電壓和電流乘積之總和。

最大電源電流 (I_{cc})

規定的負載條件下，電源電流的最大值。

最大動作溫度範圍 (T_{opt})

放大器的電機特性不會有顯著變化下，所能動作的最大周圍溫度，有最高與最低溫度的規定。

最大儲存溫度範圍 (T_{stg})

儲存狀態下，能長時間加的最大周圍溫度，而不致影響其電機性能，有最高與最低溫度的規定。

輸出短路的容許時間 (t_s)

將輸出端短路，在不會破壞放大器之前，所能容許的時間，這只限於對地短路，若是和某種電位的短路則不在此限。

② 電氣特性

開環路增益 (A_o)

按照頻率、溫度、電源電壓及負載電阻等的變化下，輸出電壓變化對輸入電壓變化之比，但對於頻率而言，一般為直流狀況之值。

大信號增益 (A_V)

放大器能夠利用的最大輸出電壓之增益，而以電源電壓及負荷阻損等為先決條件。

閉環路增益 (A_{cl})

有反饋電路之增益， A_o 非常大時（相當於一般的運算放大器），由反饋電路的阻

抗值決定。

頻帶寬度 (帶域寬) (BW)

閉環路路的向上轉移(roll-off)，不管負反饋量多少，都調整為 6dB/oct ，而且，頻帶寬度自然地由下列兩參數決定：

- (i) 在小信號處，為 f_T (增益為1之頻率) 及低頻之 A_o 。
- (ii) 大信號時，為 f_c (無失真之最大輸出頻率) 或轉動率。

轉動率 (SR)

放大器之輸出電壓的最大的時間變化率，步進輸入的最小值到最大值對時間的變化率，以 $\text{V}/\mu\text{S}$ 表示。

穩定時間 (set)

加上步進輸入時，輸出電壓到達規定的最終值的某一定誤差範圍內，所需要的時間，此種誤差範圍通常以最終輸出的幾%指示。

輸入偏滯電流 (I_{io})

用兩輸入端之流入或流出電流 (偏壓電流) 差來表示。

輸入偏壓電流 (I_I)

呈現於輸入端的電壓，以兩個端子的輸入電流之平均值來定義之。

額定輸出電壓 (V_o)

運算放大器的最大輸出電壓。

額定輸出電流 (I_o)

運算放大器的最大輸出電流，和 V_o 、 R_L 及 R_F 的關係如下：

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} \quad R_L = \frac{R_F \cdot R_L}{R_F + R_L}$$

0 dB 帶寬 (f_r)

在小信號操作中，增益為 1 (0 dB) 之頻率。

截止頻率 (f_c)

在大信號操作中，無失真之最大輸出頻率。

輸入阻抗 (Z_i)

① 差動輸入阻抗 (Z_i 差動)

放大器的差動輸入端間的開路阻抗，若無特別指定，則可做為輸入阻抗之同義語。

② 同相輸入阻抗 (Z_i 同相)

放大器的兩個輸入端和共同端 (接地端) 之間的阻抗，若屬輸入為單端放大器 (如新波輸入放大器) 等，則不記載此值。

輸出阻抗 (Z_o)

放大器的等效電源內部的阻抗，記載於資料手冊之值為開路增益時之值，故在閉環路之場合，須用環路增益餘值。

輸入偏移電壓 (V_{io})

放大器的輸入端所呈現的直流電壓，此值之決定，係在輸入為 0 時且使輸出為 0，在兩端子間所加之電壓。

共模互斥比 (CMR)

對於同相信號增益 (A_{CW}) 之差動信號增益 (開路增益) 比。

③ 漂移特性

偏移電壓、溫度漂移 ($\Delta V_{io} / \Delta T$)

對於周圍溫度變化的偏移電壓之變化量，一般用 $\mu V / ^\circ C$ 表示。也有的資料手冊用某一定溫度 (T_{op} 的最大或最小) 下的偏移電壓來表示，這時候，就用 V_{io} 及 μV 來表示。

偏移電流、溫度漂移 ($\Delta I_{io} / \Delta T$)

對於周圍溫度變化的偏移電流之變化量，用 $nA / ^\circ C$ 或 $pA / ^\circ C$ 表示。其他則和偏移電壓的情況相同。在 J-E-T 輸入之運算放大器之情形下，通常每升高 $10^\circ C$ ， I_{io} 值加倍。

偏壓電流、溫度變化 ($\Delta I_f / \Delta T$)

對於周圍溫度變化的偏壓電流之變化量，用 $nA / ^\circ C$ 或 $pA / ^\circ C$ 表示。其他則和偏移電壓的情況相同。

偏移電壓、電源漂移 ($\Delta V_{io} / \Delta S$)

對於電源電壓變化的偏移電壓之變化量，用 $\mu V / V$ 表示。這是電源電壓變化 1 V 時

，偏移電壓的變化量 (μV)。也有用 $\mu V / \%$ 表示者。這是電源電壓變化 1% 時，偏移電壓的變化量 (μV)。

偏移電壓、時間漂移 ($\Delta V_{io} / \Delta t$)

經過一段時間後，偏移電壓的變化量，單位的表示可用 $\mu V / \text{day}$ (一天的變化量)、 $\mu V / \text{Week}$ (一星期)、 $\mu V / \text{mo}$ (一個月) 及 $\mu V / \text{Year}$ (一年) 等。

電壓電壓抑制比 ($SVR + , -$)

對於電源電壓的變化所引起的偏移電壓、偏移電流及偏壓電流的變化量之比，一般用 dB 表示。

輸入換算雜訊電壓 (V_n)

把呈現於輸出的雜訊電壓，換算成輸入端者，對於某頻帶 (BW) 之值。在超低頻帶域可視為漂移電壓。DC 及低頻用 P-P (峯對峯) 值，對於帶域以上則用 rms (均方根、有效) 值表示。

輸入換算雜訊電流 (I_n)

把呈現於輸出的雜訊電流，換算成輸入端者，在超低頻帶域用 P-P 值，在中頻帶域，則用 rms 值表示等，和電壓的情況一樣。



◆運算放大器規格表的簡號・記號

① 公司名稱

A. D.	: ANALOG DEVICES
ancom	: ancom
B. H.	: BELL & HOWELL
B. B.	: BURR BRW'N
F. M. I	: FUNCTION MODULES INC.(INTECH合併)
INTECH	: INTECH
T. P.	: TELEDYNE PHILBRICK
ZEL.	: ZELTEX
アイコー	: アイコーデンキ株式会社
CR BOX	: 東京無線器材株式会社
日立	: 株式会社日立製作所
J.R.C	: 新日本無線株式会社
松下	: 松下電子工業株式会社
三菱	: 三菱電機株式会社
日電	: 日本電氣株式会社
東芝	: 東京芝浦電氣株式会社
(註) 株式会社:	有限公司

② 最大額定

V_{cc} (V_{EE}) : 電源電壓

V_{cc}	: 電源電壓範圍
V_{id}	: 差動輸入電壓(Differential Input Voltage)
V_I	: (同相) 輸入電壓
P_D	: 容許損失(Power Dissipation)
I_{cc} (I_{EE})	: 電源電流
T_{opt}	: 動作溫度範圍
T_{stg}	: 儲存溫度範圍
t_r	: 輸出短路容許時間(Output Short Circuit Duration)

③ 電氣特性

A_o	: 開環路增益
A_v	: 大信號增益
ACL	: 閉環路增益
V_o	: 輸出電壓
I_o	: 輸出電流
BW	: 頻帶寬度
f_T	: 增益為 1 (Unity Gain) 的帶域
f_c	: 截止頻率
SR	: 轉動率
Set	: 穩定時間
V_{io}	: 輸入偏移電壓
CMRR(CMR)	: 共模互斥比

- I_{io} : 輸入偏置電流
- I_i : 輸入偏置電流
- $Z_i(f_i)$: 輸入阻抗
- $Z_o(R_o)$: 輸出阻抗

4 漂移特性

- $\Delta V_{io}/\Delta T$: 輸入偏置電壓・溫度漂移
- $\Delta I_{io}/\Delta T$: 輸入偏置電流・溫度漂移
- $\Delta I_i/\Delta T$: 輸入偏置電流・溫度漂移
- $\Delta V_{io}/\Delta S$: 偏置電壓・電源漂移
- $\Delta V_{io}/\Delta t$: 偏置電壓・時間漂移
- V_n : 輸入換算雜訊電壓
- i_n : 輸入換算雜訊電流
- $SVR+$: 電源電壓抑制比(正電源)
- $SVR-$: 電源電壓抑制比(負電源)

5 測定條件

- R_s : 信號源電阻
- R_L : 負載電阻
- R_i : 輸入電阻
- R_f : 反饋電阻
- C_L : 負載電容
- DC : 直流
- AC : 交流
- $\langle A_o \rangle$: DC 、 DC 開環路 : DC 的 A_o 值
 DC 負載、 DC 、 R_L 、 DC 時的 A_o 值
 DC 無負載 : 無負載、 DC 時的 A_o 值

- 大信號 : 大信號(一般為 $V_o = (2 \sim 4)V$ 值)時之 A_o 值
- 大信號、 R_L 、 DC : 大信號, R_L 、 DC 時的 A_o 值
- $R_L = 0$: $R_L = 0$ 時的 I_{cc} 值
- $V_{cc} = 0$: V_{cc} 為零時的 I_{cc} 值
- $0 \sim 0^\circ C$: $V_{cc} = 0$ 時的 I_{cc} 值
- $0 \sim 0^\circ C$ 、 R_L 、 DC : 溫度範圍 $0 \sim 0^\circ C$ 、 R_L 、 DC 時的 V_o 值
- R_L 、 DC 、 0 : R_L 、 DC 時的 V_o 值
- $\pm V_{cc} - 0V$: 自 $\pm V_{cc}$ 減掉 $0V$ 後的值
- R_L 、 DC : R_L 、 DC 時的 I_o 值
- 小信號、 0 : 小信號, 0 時的 I_o 值
- 開環路 : 一般指小信號時的 I_o 值
- $A_v = 0$: 開環路時的 A_v
- $A_{CL} = 0$: $A_v = 0$ 時的 A_v
- 反相 : $A_{CL} = 0$ 時的 f_c
- f_c : 反相輸入的 f_c 值, 一般 f_c 為反相輸入, 若非反相輸入, 則比起資料手冊所記載者, f_c 值就差多了
- 正弦波 : 在正弦波下的 f_c 值
- $A_v = 0$: $A_v = 0$ 時的 f_c 值
- $A_o = 0$ 、開環路 : $A_o = 0$ 時的 f_c
- $0dB$: 在 $0dB$ 下的 f_c 值, 一般的 f_c 值用 $-3dB$ 下的頻率來表示
- 0 、 R_L 、 DC : 負載電阻 0 時的 SR 值
- $A_v = 0$: $A_v = 0$ 時的 SR 值

(V_{io})	ADJ 0 附加 $\circ\Omega$ 、 $\circ\Omega$ 外加 $\circ\Omega$ 、Null 不外加Null	: 可從外面調整為 0 : 附加電阻 $\circ\Omega$ 時的 V_{io} 值 外面附加 $\circ\Omega$ 電阻時的 V_{io} 值 : 外面不附加電阻調整用的阻抗時的 V_{io} 值	DC (Z_o) $\circ\text{Hz}$ DC $\sim\circ\text{Hz}$ ($\Delta V_{io}/\Delta T$) $\circ\sim\circ\text{Hz}$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$, $A_{CL}=\circ$: 某溫度範圍及 A_{CL} 下的 $\Delta V_{io}/\Delta T$: 直流的 Z_i : 在某頻率下的 Z_o : 從直流到某頻率的 Z_o : 某溫度範圍下的 $\Delta V_{io}/\Delta T$: 某溫度範圍及 A_{CL} 下的 $\Delta V_{io}/\Delta T$
	$R_s \geq \circ\Omega$ (CMR/R_i) + $\circ\text{V}$ - $\circ\text{V}$ $R_s \leq \circ\Omega$, $\circ\sim\circ\text{Hz}$: $R_s \geq \circ\Omega$ 時的 V_{io} 值 : 輸入電壓在 + $\circ\text{V}$ - $\circ\text{V}$ 以內的 CMR : 在某溫度條件下, $R_s \leq \circ\Omega$ 時的 CMR	$\circ\sim\circ\text{Hz}$, $A_v=\circ$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ 每 10°C 加倍 $R_s \geq \circ\Omega$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ (SVR) $R_s \circ\Omega$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ $R_s \circ\Omega$, $BW \circ\text{Hz}$, A_v = \circ DC $\sim\circ\text{Hz}$, $A_{CL}=\circ$ BW $\circ\text{Hz}$, $A_v=\circ$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ 最終值 0.01%	: 某溫度範圍及 A_v 下的 $\Delta V_{io}/\Delta T$: 某溫度範圍下的 $\Delta I_{io}/\Delta T$: 每 10°C 誤值加倍 : 某輸入電阻下的 $\Delta V_{io}/\Delta S$: 某溫度範圍下的 $\Delta V_{io}/\Delta S$: 某溫度範圍下的 $\Delta V_{io}/\Delta I$: 某輸入電阻下的 SVR : 某溫度範圍下的 SVR : 某頻率範圍下的 V_n : 某輸入電阻、帶寬及 A_v 下的 V_n
	$\circ\text{V}$, $\circ\text{Hz}$, $A_v=\circ$ DC $A_{CL} \circ$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ 反相輸入 非反相輸入 差動 // $\circ\text{pF}$ 同相 // $\circ\text{pF}$ 差動同相 // $\circ\text{pF}$: 在某輸入電壓、頻率及大信號增益下的 CMR : 在 DC 值下的 CMR : 在某 A_{CL} 值下的 CMR : 某溫度範圍下的 I_{IS} : 反相輸入的 I_{IS} : 非反相輸入的 I_{IS} : 差動輸入電容 $\circ\text{pF}$ 時的 Z_i : 同相輸入電容 $\circ\text{pF}$ 時的 Z_i : 差動、同相及輸入電容均為同樣值的 Z_i	$\circ\sim\circ\text{Hz}$, $A_v=\circ$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ $R_s \circ\Omega$, $BW \circ\text{Hz}$, A_v = \circ DC $\sim\circ\text{Hz}$, $A_{CL}=\circ$ BW $\circ\text{Hz}$, $A_v=\circ$ $\circ\sim\circ\text{Hz}$ 最終值 0.01%	: 某輸入電阻、帶寬及 A_v 下的 V_n : 從 DC 到某頻率及某 A_{CL} 下的 V_n : 某帶寬及 A_v 下的 V_n : 某頻率範圍內的 i_n : 到達最大輸出 0.01% 時的穩定時間 : 補償用電容 : 溫度控制用 : I_{CC} 的設定 : 決定放大率的偏壓電流
	差動低頻 同相 差動	: 在差動且低頻下的 Z_i : 同相的 Z_i : 差動的 Z_i	C, C _c , C _L 加熱器 I _{SET} I _{ABC}	

⑥ 單位

$m A = 10^{-3} A$: 毫(multi)安培
$\mu A = 10^{-6} A$: 微(micro)安培
$n A = 10^{-9} A$: 奈(nano)安培
$p A = 10^{-12} A$: 派(pico)安培
$f A = 10^{-15} A$: 飛(femto)安培
$m V = 10^{-3} V$: 毫伏特
$\mu V = 10^{-6} V$: 微伏特
$K \Omega = 10^3 \Omega$: 千歐姆
$M \Omega = 10^6 \Omega$: 百萬歐姆
Sec	: 秒

⑦ 外觀・電路

A1 OUT, A2 IN, A2SJ : 參照F.M.I.資料手冊

ACL : 閉環路增益

Aluminum Anodized Header Plate : 鋁板

B +, B - : 正電源, 負電源

BAL., Balance : 平衡

BAND WIDTH CONTROL : 頻帶寬度調整

BW : 頻帶寬度

C', C₀, C₁, C₂, C_c, C_f : 補償用電容

CMR TRIM, CMR ADJ. : CMR調整

COM., COMMON : 共同端

COMP., Compensation Comp A, Comp B : 頻率補償(A, B)

COMP. CAP., Compensation Capacitor : 頻率補償電容

DIA : 直徑

E_b	: 電源電壓
$\epsilon_{in}, \epsilon_{out}$: 輸入電壓, 輸出電壓
Equally Spaced	: 空白
EXT, POT, External Bt	: 外面電位計(偏移調整用)
F ₁ , F ₂	: 頻率補償端
Feed Forward Comp	: 前饋補償用端子
Frequency Compensation Freq. Comp. A(B)	: 頻率補償A, B(電容)
GAIN	: 增益
GND., GROUND	: 接地
Gold Plated Leads	: 鍍金端子
GUARD(PIN)	: 輸入保護(電機上的)
$I_1, I_N \rightarrow in^-$: 反相輸入
$I_{N1}, I_{N2} \rightarrow in^+$: 非反相輸入
I_{N1}, I_{N2}	: 輸入1, 輸入2
Input ground	: 輸入接地
INPUT LAG	: 輸入修正
Input offset trim	: 偏移調整之用電位計
INV. INPUT, Inverting input	: 反相輸入
Insulator	: 爲保持IC(金屬罐)的間隔所裝設之物
Int. Trim.	: 偏移調整用之電位計
Leads	: 接腳數目
NC	: 無連接
Neg. Supply	: 負電源
No.4-40 THD $\times 0.06$: 4-40粗細 $\times 0.06$ 深淺	
NON INV. IN, NON INV. INPUT, Non Inverting Input	: 非反相輸入